

200mm Silicon Wafer Specification

Spec No.(编号) :

Revision(版本号) :

审核：宁永铎

序号： GK/CGMP-2536

Characteristics 参数		Unit (单位)	Secification Value (规范值)	Remarks (备注)
材料	Material		Polished Wafer	
等级	Grade		Prime	
生长方法	Crystal Growth Method		FZ-GD	
导电类型	Conductivity Type		P	
掺杂剂	Dopant		Boron	
电阻率	Resitivity	Ω·cm	>10000	*
电阻率径向均匀性	RRV-max	%	/	
氧含量	Oxygen Concerntration	ppma	<0.2 (ASTM F121-83)	*
氧径向变化	ORV-max	%	/	
碳含量	Carbon Concerntration	ppma	<0.2	*
少子寿命	Lifetime	us	/	
体金属沾污	Bulk Metal Contamination	at/cm ³	/	
位错密度	Dislocation Density	ea/cm ²	None	
微缺陷密度	OISF	ea/cm ²	None	
晶体原生颗粒	COP	ea/wafer	/	
漩涡	Swirl		None	
滑移线	Slip		None	
晶向及晶向偏移度	Crystal Orientation	°	<100>0±0.5	*
主参考面位置	Primary Notch Location	°	(110)±1.0	*
主参考面长度	Primary Notch Depth	mm	1-1.25 ; 89-95 °	*
副参考面位置	Secondary Flat Location	°	None	
副参考面长度	Secondary Flat Length	mm	None	
直径	Diameter	mm	200±0.2	*
参考面直径	Diameter Perpendicular To Primary Flat	mm	/	
倒角	Edge Contour	° / um	22° ; R-Contour ; Symmetric	*
厚度及公差	Thickness	um	725±10	*
TTV	TTV	um	<3	*
TIR	TIR	um	<2	*
BOW	BOW	um	<30	*
WARP	WARP	um	<30	*
STIR	SFQR / SBIR	um	<0.5 (25mm*25mm) /	*
激光刻字	Laser Mark		Backside ; SEMI M13	
正表面	Front Surface		Polished	
背表面	Backside Surface		Acid etched	
背表面工艺	Backside POLY	A	/	
背表面工艺	Backside LTO	A	/	
背表面粗糙度	Backside Roughness	um	/	
背表面光泽度	Backside Gloss	GU	/	
边缘抛光	Edge Polishing		Yes	
表面颗粒	Light Point Defects	ea/wafer	≤20(≥0.2um) ; ≤10(≥0.3um) ; ≤5(≥0.5um)	*
表面金属	Front Surface Chemistry	ea/cm2	<1E10(Na Al K Ca Cr Fe Ni Cu Zn)	*

表面质量	Surface Qulity (Scratches 、Crack、Edge chip、 Contamination)		None	
包装	Package		Entegris or ePAK ; 25pcs/box	
备注	Remarks		/	